

LAPT

2SA1216

シリコンPNPエピタキシャルプレーナ型トランジスタ (2SC2922とコンプリメンタリ)

用途：オーディオ、一般用

絶対最大定格 (Ta=25)

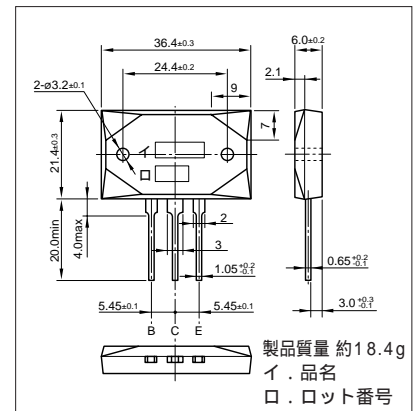
記号	規格値	単位
V _{CB0}	-180	V
V _{CEO}	-180	V
V _{EBO}	-5	V
I _C	-17	A
I _B	-5	A
P _C	200(T _C =25)	W
T _{ij}	150	
T _{stg}	-55 ~ +150	

電気的特性 (Ta=25)

記号	試験条件	規格値	単位
I _{CB0}	V _{CB} = -180V	-100max	μA
I _{EBO}	V _{EB} = -5V	-100max	μA
V _{(BR)CEO}	I _C = -25mA	-180min	V
h _{FE}	V _{CE} = -4V, I _C = -8A	30min	
V _{CE(sat)}	I _C = -8A, I _B = -0.8A	-2.0max	V
f _T	V _{CE} = -12V, I _E = 2A	40typ	MHz
COB	V _{CB} = -10V, f = 1MHz	500typ	pF

ランク O(30~60), Y(50~100), P(70~140), G(90~180)

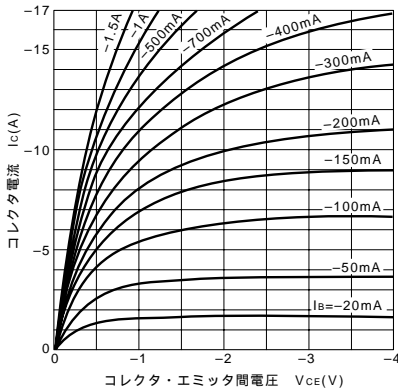
外形図 MT-200



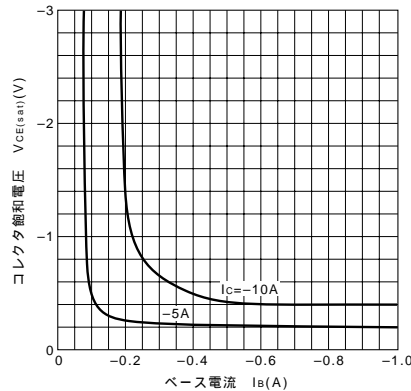
代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	V _{B2} (V)	I _{B1} (A)	I _{B2} (A)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
-40	4	-10	5	-1	1	0.3typ	0.7typ	0.2typ

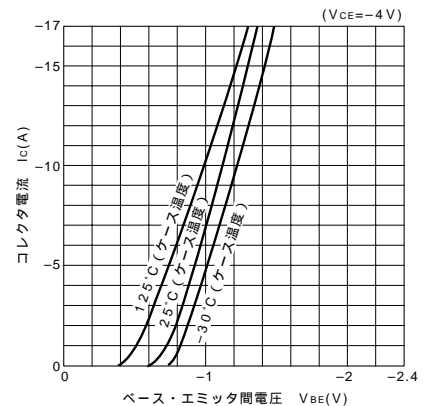
I_C-V_{CE}特性 (代表例)



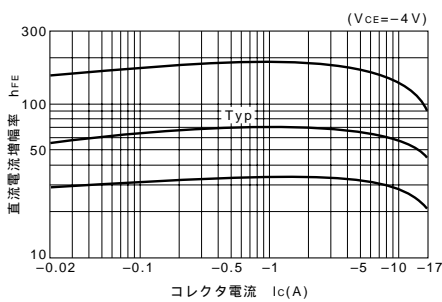
V_{CE(sat)}-I_B特性 (代表例)



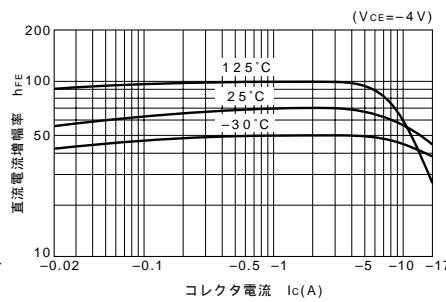
I_C-V_{BE}温度特性 (代表例)



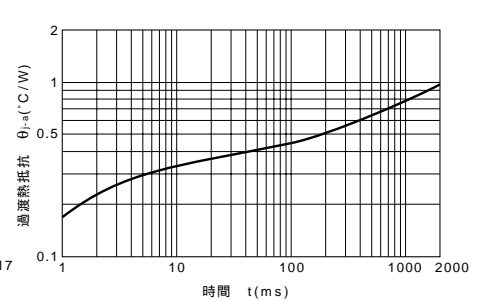
h_{FE}-I_C特性 (代表例)



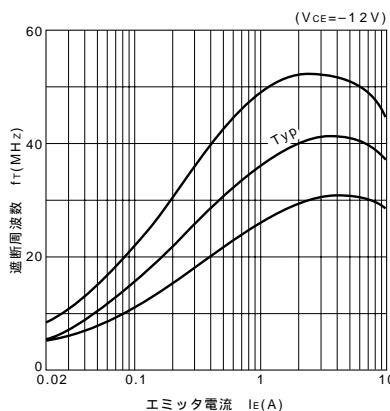
h_{FE}-I_C温度特性 (代表例)



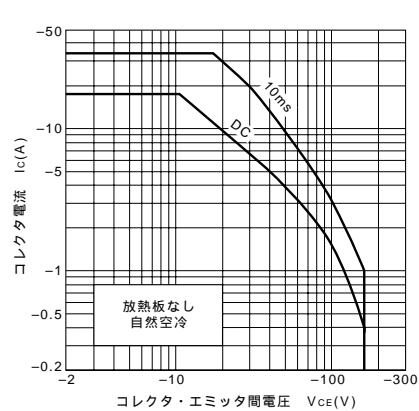
θ_{j-a}-t特性



f_T-I_E特性 (代表例)



ASO曲線 (単発パルス)



P_C-T_a定格

